

CentralTM Semiconductor Corp.

145 Adams Avenue, Hauppauge, NY 11788 USA
Tel: (631) 435-1110 • Fax: (631) 435-1824

Manufacturers of World Class Discrete Semiconductors

2N3009
2N3013
2N3014

NPN SILICON HIGH SPEED
SWITCHING TRANSISTORS

JEDEC TO-18 CASE

DESCRIPTION

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N3009, 2N3013, 2N3014 types are Silicon NPN switching Transistors designed for high speed, medium power saturated switching applications.

MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL	2N3009	2N3013	2N3014	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CB0}	40	40	40	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	40	40	40	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	15	15	20	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	4.0	5.0	5.0	V
Collector Current	I_C	200	200	200	mA
Collector Current Peak (10 μ s pulse)	I_C	500	500	500	mA
Power Dissipation	P_D	360	360	300	mW
Power Dissipation ($T_C=25^{\circ}\text{C}$)	P_D	1.2	1.2	1.2	$\frac{\text{W}}{^{\circ}\text{C}}$
Oper. and Storage Junction Temp.	T_J, T_{stg}		-65 TO +200		$^{\circ}\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	2N3009		2N3013		2N3014		UNIT
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
I_{CES}	$V_{CE}=20\text{V}$		0.5		0.3		0.3	μA
I_B	$V_{CE}=20\text{V}, V_{BE}=0$		0.5		0.3		0.3	μA
BV_{CB0}	$I_C=100\mu\text{A}$	40		40		40		V
BV_{CES}	$I_C=100\mu\text{A}$	40		40		40		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	15		15		20		V
BV_{EBO}	$I_E=100\mu\text{A}$	4.0		5.0		5.0		V
$V_{CE}(\text{SAT})$	$I_C=30\text{mA}, I_B=3.0\text{mA}$		0.18		0.18		0.18	V
$V_{CE}(\text{SAT})$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$		0.28		0.28		0.35	V
$V_{CE}(\text{SAT})$	$I_C=300\text{mA}, I_B=30\text{mA}$		0.5		0.5		-	V
$V_{CE}(\text{SAT})$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$		-		-		0.18	V
$V_{BE}(\text{SAT})$	$I_C=30\text{mA}, I_B=3.0\text{mA}$	0.75	0.95	0.75	0.95	0.75	0.95	V
$V_{BE}(\text{SAT})$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$		1.2		1.2		1.2	V
$V_{BE}(\text{SAT})$	$I_C=300\text{mA}, I_B=30\text{mA}$		1.7		1.7		-	V
$V_{BE}(\text{SAT})$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$	-	-	-	-	0.7	0.8	V
h_{FE}	$V_{CE}=0.4\text{V}, I_C=30\text{mA}$	30	120	30	120	30	120	
h_{FE}	$V_{CE}=0.4\text{V}, I_C=10\text{mA}$	-	-	-	-	25	-	
h_{FE}	$V_{CE}=0.5\text{V}, I_C=100\text{mA}$	25	-	25	-	-	-	
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=100\text{mA}$	-	-	-	-	25	-	
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=300\text{mA}$	15	-	15	-	-	-	
f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=30\text{mA}, f=100\text{MHz}$	350	-	350	-	350	-	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=5.0\text{V}, I_E=0, f=140\text{kHz}$		5.0		5.0		5.0	pF
C_{ib}	$V_{BE}=0.5, I_C=0, f=140\text{kHz}$		8.0		8.0		8.0	pF
t_{on}	$V_{CC}=15\text{V}, I_C=300\text{mA}, I_{B1}\approx 30\text{mA}$		15		15		-	ns
t_{on}	$V_{CC}=2.0\text{V}, I_C=30\text{mA}, I_{B1}\approx 3.0\text{mA}$		-		-		16	ns
t_{off}	$V_{CC}=15\text{V}, I_C=300\text{mA}, I_{B1}\approx I_{B2}\approx 30\text{mA}$		25		25		-	ns
t_{off}	$V_{CC}=2.0\text{V}, I_C=30\text{mA}, I_{B1}\approx I_{B2}\approx 3.0\text{mA}$		-		-		25	ns
τ_s	$I_C\approx I_{B1}\approx I_{B2}\approx 10\text{mA}$		18		18		18	ns

OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix "TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix "PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9